

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

29.09.2023 № 15-обр.

г. Томск

О зачислении в аспирантуру
и назначении стипендии аспирантам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденными приказом директора института № 4-обр. от 28.03.2022 г., и на основании протокола заседания приемной комиссии № 2 от 29 сентября 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ходжаева Парвиза Зафаровича с 02 октября 2023 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по научной специальности 1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки, и установить Ходжаеву П.З. с 02 октября 2023 года по 31 августа 2024 года ежемесячную стипендию в размере 11255,73 руб.

Директор института
д.ф.-м.н.



И.В. Романченко

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ООД



И. В. Пегель

Врио начальника ПЭО



И. П. Лобыня